Перв. примен.		Формат	Зана	Поз.	Обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
						<u>Документация</u>			
		A4			MFT9.111111.001-01 90	Томинаское оддание		1	
		A4 A4			MFTY.111111.001-01 90	Техническое задание Расчетно-пояснительная	מחווכונם	1	
Cnpaß. №		A4			MFT9.111111.001-01 33	Руководство администрат		1	
		A4			MFT9.111111.001-01 34	Руководство авманастрат	ιομα	1	
		A4			MFT9.111111.001-01 12	Текст программы		<u>'</u> 1	
		Λ4 Α4			MFT9.111111.001-01 13	Описание программы		1	
		A4			MFTY.111111.001 90	Блок-схема алгоритма		1	
		A3			MFTY.111111.001 31	Схема электрическая стру	ктирная	1	
		A3			MFTY.111111.001 33	Схема электрическая принципиальная		1	
Ш		Α4			МГТУ.111111.001 ПЭЗ	Перечень элементов		1	
		A2			MFTY.111111.001 C6	Сборочный чертеж		1	
		<b>A</b> 3			MΓΤΥ.111111.001 BΠ	Ведомость покупных издел	านนิ	1	
ma ma									
u dam						<u>Детали</u>			
Подп. и да									
		A3		1	MFT9.111111.002	Плата печатная		1	
Инв. № дубл.									
						Покупные изделия			
		-				Кондонеаторы			
Взам. инв. №						<u>Конденсаторы</u>			
				2		C0603 C0603C104J4RACTU		7	C1,C5,C6,C11
						(0,1mkΦ ± 5%) Kemet Electronics		'	C13, C14, C17
Подп. и дата						10, IIII + 1 370) NEIIEI EICEI	I UIIIC3		C13, C14, C17
Todn. L		NACTII				<u> </u>			
		Изм.	МГТУ.11111.001 м. Лист № докум. Подп. Дата						
Эдл.		Разраб. Могучев Л. А. Пров. Рафиков А. Г. БЛОК УГ		огучев Л. А.	/lum.		/lucm	/lucmob	
Инв. № подл.				Driok !	правления ККМ   Ц Ц	MFTY u	<u> </u>	Баумана	
NHB		Н.контр. Утв.						 каф. <i>V</i>	

ЭОНО	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечани
	3		C0603 C0603C160J5GACTU	4	C2,C3,C9,C
			(16nΦ ± 5%) Kemet Electronics		
	4		C0603 C0603C106M9PACTU	4	C4,C7,C8,C
			(10мкФ ± 20%) Kemet Electronics		
	5		C0603 C0603B105K250	7	C15,C16,C18,C
			(1мкФ ± 10%) Kemet Electronics		C21 C23
	6		C0603 C0603C475M8PACTU	1	C20
			(4,7мκΦ ± 10%) Kemet Electronics		
			<u>Микросхемы</u>		
	7		LD1117S33CTR	1	DA1
			(SOT-223) STMicroelectronics		
	8		USBLC6-2SC6	2	DA2, DA3
			(SOT-23-6) STMicroelectronics		
	9		M24C64-WMN6P	1	DD1
			(SOIC-8) STMicroelectronics		
	10		ENC28J60-I/S0	1	DD2
+			(SOIC-28) Microchip Technology		
	11		PIC18F27J53-I/S0	1	DD3
+			(SOIC-28) Microchip Technology		
	12		CP2102 CP2102-GM	1	DD4
+			(QFN-28) Silicon Labs CP2102-GM		
	<u> </u>		<u> </u>		Лu

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат	103.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
	13		MAX232IDR	1	DD5	
	כו		(SOIC-16) Texas Instruments		כטט	
			<u>Резисторы</u>			
	14		RC0603 RC0603JR-07150RL	2	R1, R2	
			(1500m ± 5%) Yageo			
	1_					
	15		RC0603 RC0603JR-0710K (10k0m ± 5%) Yageo	3	R3, R4, R8	
			(TOKOM ± 376) Tugeo			
	16		RC0603 RC0603FR-074K7L	4	R5,R6,R10,R11	
			(4,7ĸ0m ± 1%) Yageo			
	17		RC0603 RC0603FR-072KL	1	R7	
+	17		(2x0m ± 1%) Yageo		K I	
			3			
	18		RC0603FR RC0603FR-071K5L	1	R9	
$\bot$			(1,5x0m ± 1%) Yageo			
			<u>Разъемы</u>			
+	19		HR911105A HANRUN	1	XS1	
	20		S4B—EH 2.5mm JST Corporation	1	XS2	
+			3 18 Em Elsammas r comportation	<u>'</u>	7.32	
	21		DS-313 1,3x4,2mm Dragon City	1	XS3	
	00		LICDA M CM T	1	VCI	
+	22		USBA-M-SM Tyco Electronics	1	XS4	
$\dagger \dagger$	23		DRB-9MA Connfly electronic	1	XS5, XS6	
苗			MFTY.111111.001	•	/lucm	
Изм. /	Изм. /ист № докум. Подп. Дата Корировал Формал А/-					

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Кварцевые резонаторы		
		24		KX-5 SMD CRYSTAL CSX3-AC1-16-25	1	ZQ1
				(16,0 MHz) Crystek Corporation		
		25		KX-5 SMD CRYSTAL CSX3-AC1-16-25	1	ZQ2
				(25,0 MHz) Crystek Corporation		
				<u>Материалы</u>		
				Припой ПОС-61	15	гр.
				Краска XV401 F–2W	10	гр.
				Клей резиновый ИКФ–130	5	гр.
				Лак URETHAN 71	15	гр.
				Паяльная маска XV501 T–4G	20	гр.
+				Паяльная паста 93,5Sn/3Sb/2Bi/1,5Cu	10	гр.
				ANSI/J-STD-005		
_						
_						
	<u> </u> 			METH 44444 004		Лист
Изи	1. /lu	cm	№ докум. Подп. Дата	MFTY.111111.001	Фолмал	4

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.